

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0205U004166

Державний реєстраційний номер: 0104U003303

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 03-03-2005

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розробка методики виготовлення монокристалів вольфрамата свинцю для сцинтиляційної техніки. Випуск дослідних партій елементів.

Початок етапу: 01.2004

Закінчення етапу: 12.2004

Вид звітнього документа: Пояснювальна записка

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут монокристалів НТК "Інститут монокристалів" Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 00210217

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (057)332-23-31

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442396594, 380442343243

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 – договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрямок фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розробка методики вирощування монокристалів вольфрамата свинцю для реєстрації високоенергетичного гамма-випромінювання

Назва роботи англійською:

Development of technique for the growth of lead tungstate single crystals for registration of high-energy gamma-radiation

Реферат українською:

Визначено оптимальні технологічні умови підготовки сировини, розроблена лабораторна методика приготування шихти вольфрамату свинцю керамічним способом із компонентів PbO і WO₃. Вивчено вплив різних технологічних факторів при вирощуванні великих кристалів PbWO₄ на їх сцинтиляційні і оптичні параметри, вибрано режими процесу вирощування й відпалу кристалів, збільшено вихід придатних кристалів для сцинтиляційної техніки.

Реферат англійською:

Optimum technological conditions for preparation of the raw material are established; developed is a laboratory technique for preparation of lead tungstate raw material by the ceramic method from the components PbO and WO₃. Studied is the influence of different technological factors at the growth of large-size PbWO₄ crystals on their scintillation and optical parameters. The crystal growth and annealing regimes are chosen. The output of the crystals applicable for scintillation devices is increased.5635

Індекс УДК: 539.2;538.9-405;548, [548.5:546.815'78'21]+539.1.074

Коди тематичних рубрик: 29.19

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Космина Мирон Богданович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Пузіков Вячеслав Михайлович

Перелік осіб-виконавців

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Телефон

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

